



深圳龙泰信半导体有限公司

13001 S8D

● 主要特点

- 1. 击穿电压高
- 2. 开关速度快
- 3. 安全工作区宽
- 4. 符合ROHS规范

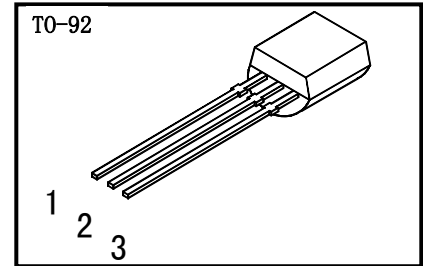
● 主要用途

节能灯, 电子镇流器等开关电路

● 芯片尺寸:

0.83mm*0.83mm

● 订购信息:

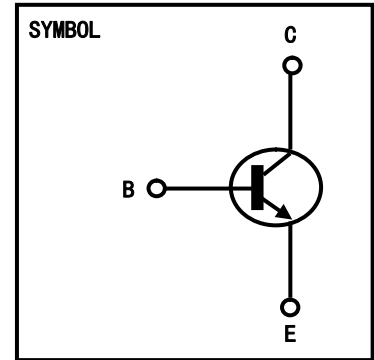


1:Emitter 2:Collector 3:Base

型号	打印标记	封装	框架材质
EB 13001(8D)	EB 13001 S8D	TO-92	Fe

● 绝对最大额定值(Tc=25℃)

项目	符号	数值	单位
集电极-基极直流电压	V_{CBO}	700	V
集电极-发射极直流电压	V_{CEO}	480	V
发射极-基极直流电压	V_{EBO}	9	V
集电极耗散功率	P_C	7	W
集电极电流	I_C	0.5	A
最高结温	T_j	150	℃
贮存温度范围	T_{stj}	-55~150	℃



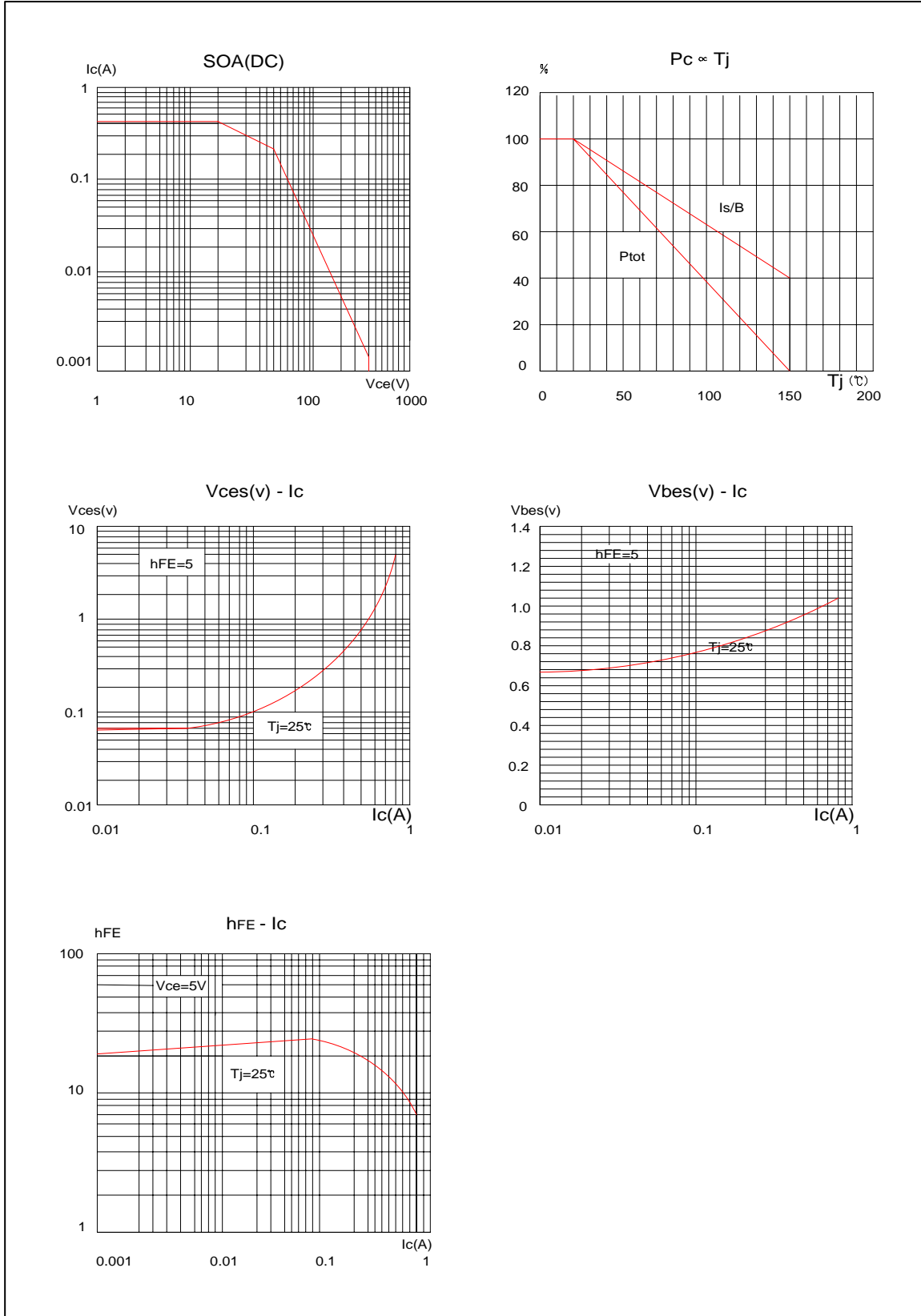
● 电特性 (Ta=25℃)

项目	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极直流电压	BV_{CBO}	$I_C=1mA$	$I_E=0$	700			V
集电极-发射极直流电压	BV_{CEO}	$I_C=10mA$	$I_B=0$	480			V
发射极-基极直流电压	BV_{EBO}	$I_E=1mA$	$I_C=0$	9			V
集电极---基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=600V$	$I_E=0$			10	μA
集电极---发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=400V$	$I_B=0$			10	μA
发射极---基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=9V$	$I_C=0$			10	μA
集电极---发射极饱和压降	V_{CEsat}	$I_C=100mA$	$I_B=20mA$			0.6	V
基极---发射极饱和压降	V_{BEsat}	$I_C=100mA$	$I_B=20mA$			1.2	V
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5V$	$I_C=1mA$	7			
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=20V$	$I_C=20mA$	15		35	
下降时间	t_f	$V_{CC}=5V, I_C=0.1A$				1.0	μs
贮存时间	t_s	(UI9600)		1.0		2.5	μs

● $h_{FE(2)}$ 分档

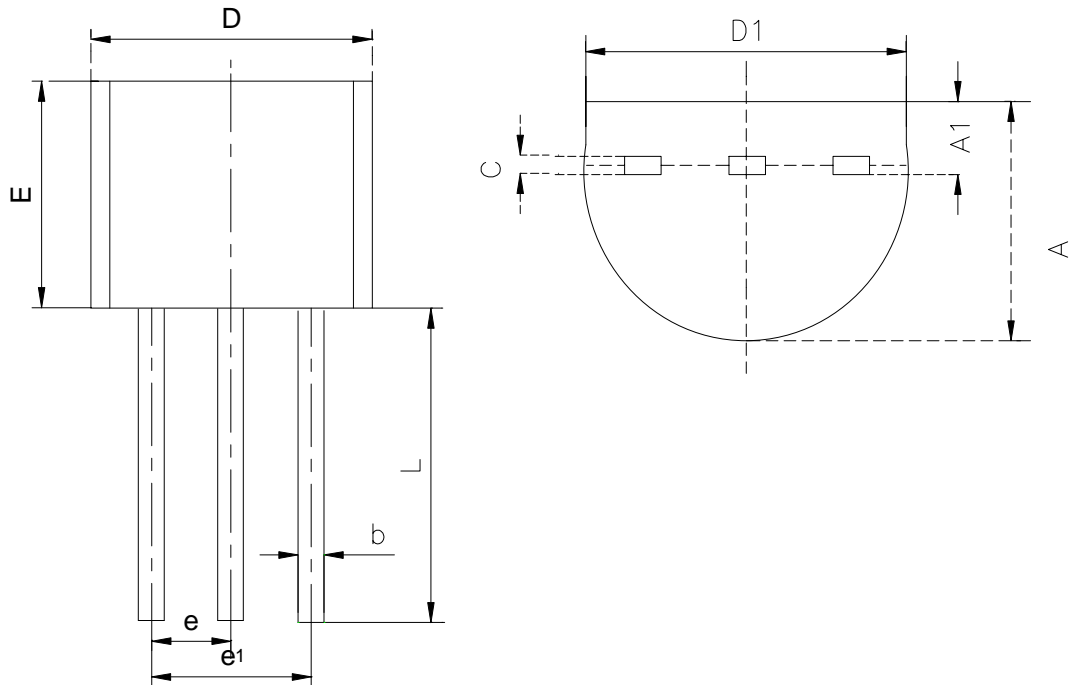
分档	A	B	C	D
范围	15~20	20~25	25~30	30~35

● 特性曲线



● 外形尺寸

单位: mm



Symbol	Dimensions in millimeters		Dimensions in inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	3.45	3.55	1.358	1.398
A1	1.55	1.65	0.610	0.650
b	0.40	0.50	0.157	0.197
c	0.35	0.45	0.138	0.177
D	4.50	4.60	1.772	1.811
D1		4.50		1.772
E	4.50	4.60	1.772	1.811
e	1.27		0.500	
e1	2.54		1.000	
L	13.95		5.492	